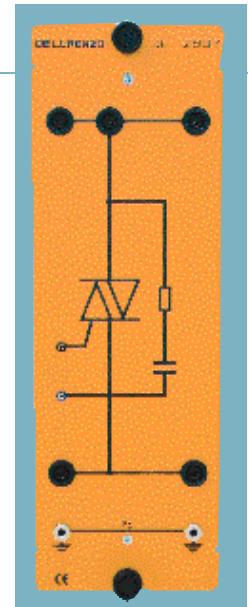


**DL 2605**  
**GRUPO DE SCR**  
 Seis SCR con red RCD de protección apropiados para realizar rectificadores controlados e inverter.

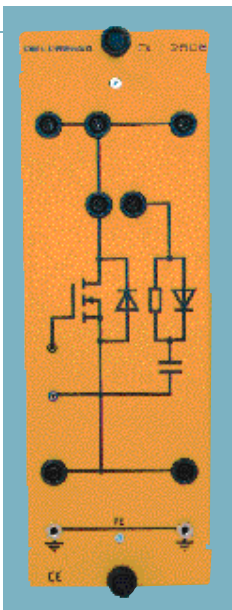
Características técnicas:  
 Corriente directa media  
 $I_{TAV} = 7,6 \text{ A max.}$   
 Valor eficaz de la

corriente directa  $I_{TRMS} = 12 \text{ A}$   
 Máximo voltaje inverso repetitivo  $U_{RRM} = 800 \text{ V}$   
 Corriente de inicio  $I_{GT} = 15 \text{ mA max.}$   
 Voltaje de inicio  $U_{GT} = 1,5 \text{ V max.}$   
 $I^2t = 72 \text{ A}^2\text{s}$



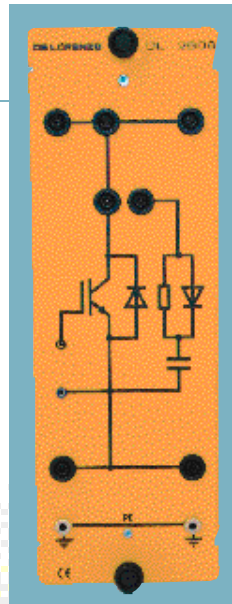
**DL 2607**  
**TRIAC**  
 Tiristor bidireccional usado para el control en corriente alternada. Incluye la red RC de amortiguación.

Características técnicas:  
 Valor eficaz de la corriente directa  $I_{TRMS} = 8 \text{ A}$   
 Corriente de pico no repetitiva  $I_{TSM} = 70 \text{ A, 50 Hz (77 A, 60 Hz)}$   
 Máximo voltaje directo repetitivo  $U_{DRM} = 800 \text{ V}$   
 Corriente de inicio  $I_{GT} = 25 \text{ mA max. (todos los cuadrantes)}$   
 Voltaje de inicio  $U_{GT} = 2,5 \text{ V max.}$   
 Corriente de mantenimiento  $I_H = 25 \text{ mA max.}$   
 $I^2t = 24 \text{ A}^2\text{s}$



**DL 2608**  
**MOSFET**  
 MOS de potencia a canal N a enriquecimiento con diodo inverso de protección (FRED, Fast Recovery Epitaxial Diode) usado como interruptor veloz en los reguladores a conmutación y en los inverter.

Características técnicas:  
 Voltaje drain-source  $U_{DS} = 400 \text{ V}$   
 Corriente continua de drain  $I_D = 10 \text{ A}$   
 Resistencia drain-source en el estado on  $R_{DS(on)} = 0,55$   
 Voltaje gate-source  $U_{GS} = \pm 20 \text{ V}$



**DL 2609**  
**IGBT**  
 Transistor bipolar con gate aislado (IGBT) a canal N con diodo inverso ultraveloz de protección usado como interruptor veloz en reguladores a conmutación y en los inverter.

Características técnicas:  
 Voltaje colector-emisor  $U_{CES} = 600 \text{ V}$   
 Corriente continua de colector  $I_C = 24 \text{ A a } T_C = 24 \text{ }^\circ\text{C}$

Voltaje de saturación colector-emisor  $U_{CEsat} = 1,8 \text{ V}_{typ.}$  a  $I_C = 15 \text{ A}$   
 Voltaje gate-emisor  $U_{GE} = \pm 20 \text{ V}$